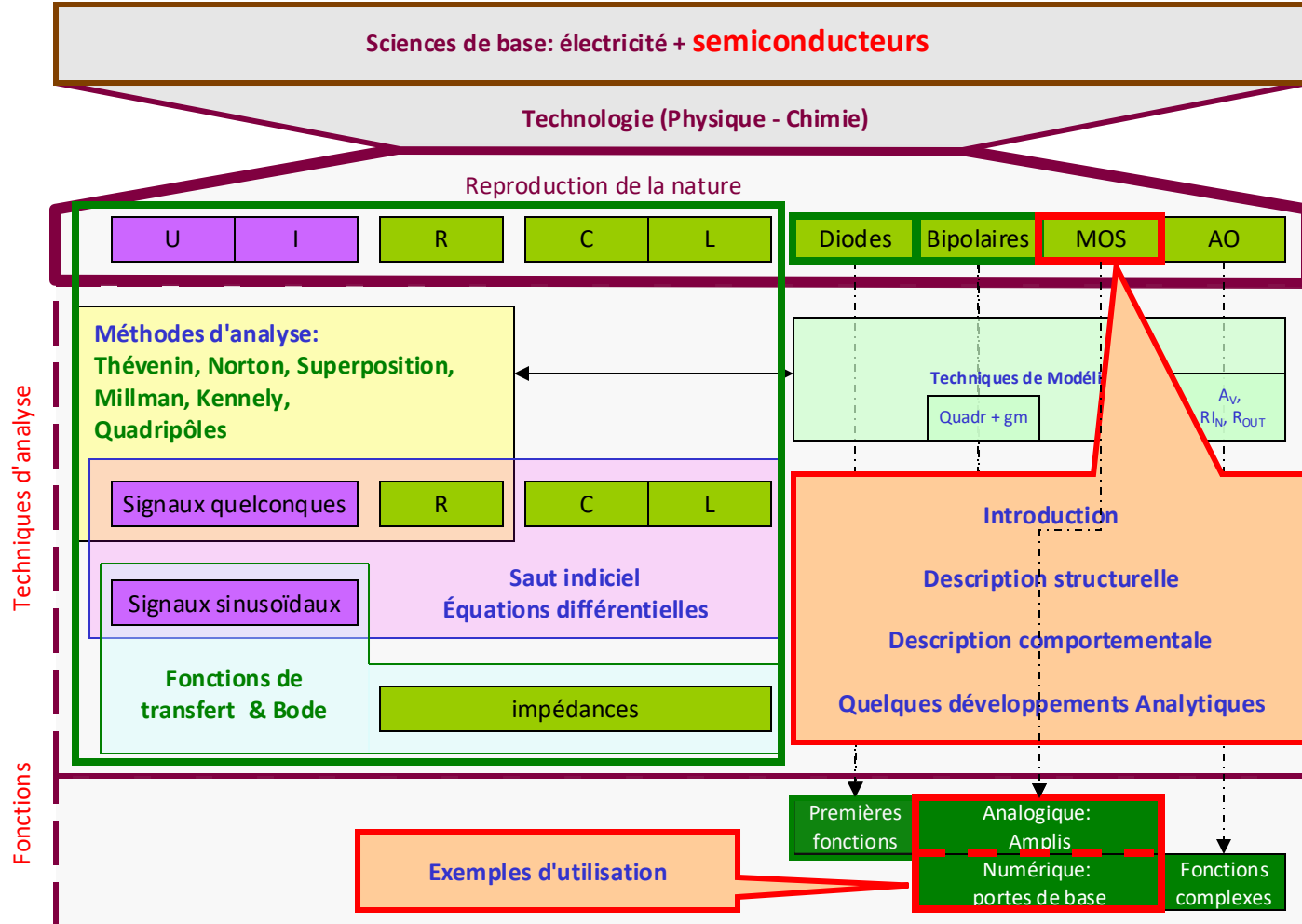


Relations entre les différentes notions



Introduction

Avant

Transistor à effet de champ:

- Connue bien avant le bipolaire

Technologie difficile à maîtriser

- V_T

Réponse en fréquence loin d'atteindre les performances actuelles

- très dépendante des dimensions géométriques
- du processus de fabrication

Actuellement

Technologie MOS mieux maîtrisée

Technologie MOS supplante Bipolaire:

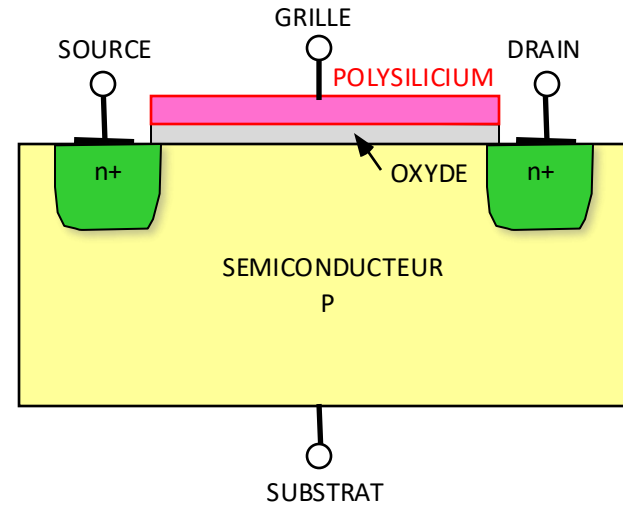
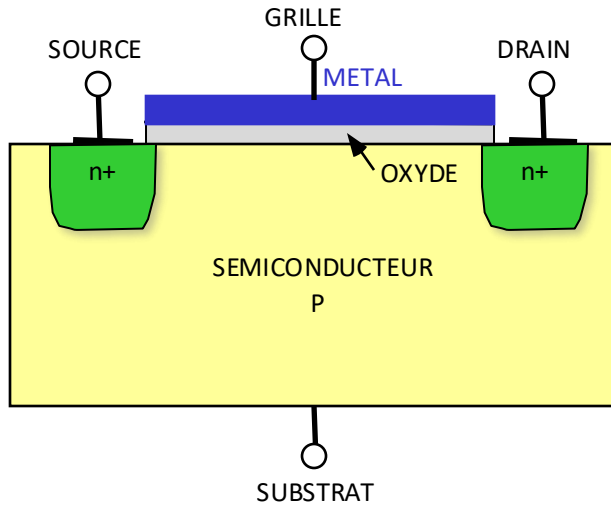
- Circuits logiques intégrés VLSI
- Certaines fonctions analogiques.

Avantages du MOS vis-à-vis du bipolaire

| | |
|---------------------|---|
| Coût technologique | { Structure très simple (plusieurs milliards de transistors sur 1 puce) Surface réduite Isolation naturelle <ul style="list-style-type: none">- Composants vis-à-vis des composants voisins,- Pas de "caissons d'isolation » Limitation du nombre d'étapes de fabrication |
| Coût de conception | { Structure très simple (bis) |
| Coût d'exploitation | { Consommation très faible <ul style="list-style-type: none">- En particulier pour les circuits CMOS |
| Divers | { Très haute impédance d'entrée. Possibilité de réaliser des fonctions complexes <ul style="list-style-type: none">- Moins de composants que les bipolaires- Exemple : les mémoires dynamiques |

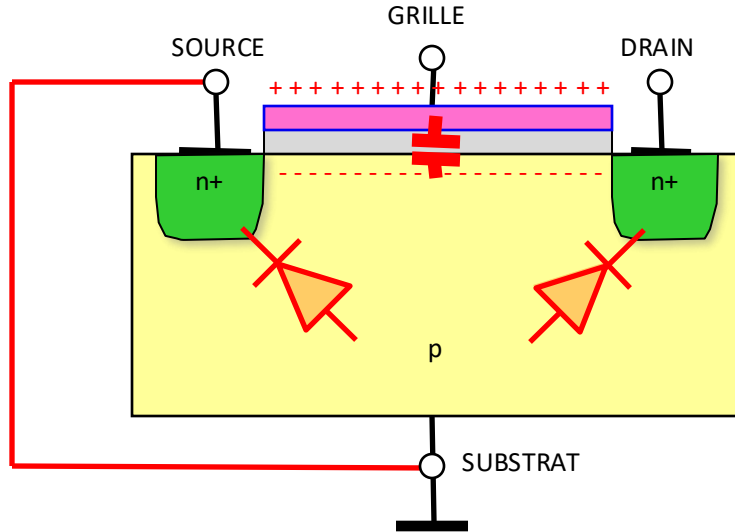
Description structurelle

MOS : Metal Oxide Semiconductor Grille Metal ou Polysilicium



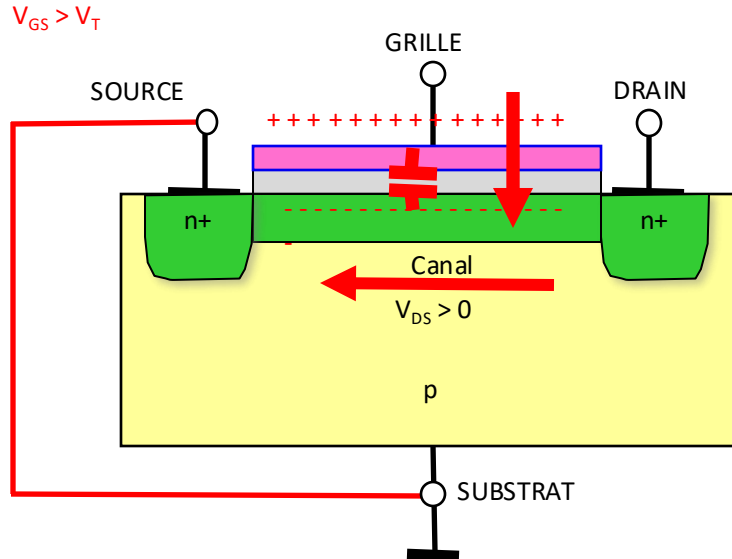
Caractéristiques électriques

MOS à Canal N



- Oxyde fin
- Capacité $\rightarrow I_G = 0$
- Dispositif symétrique
- Diodes polarisées en inverse
- Souvent, Source reliée au substrat

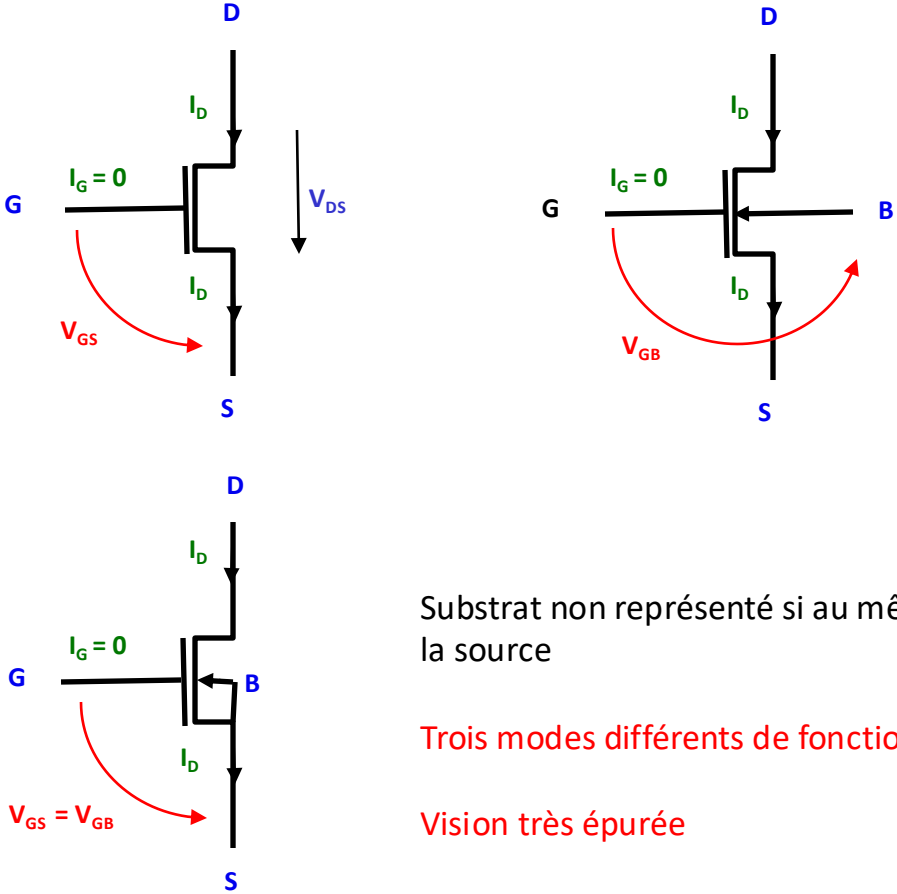
Principe de fonctionnement



Principe

- $V_{GB} > V_T$
 - Accumulation de charge à l'interface SiO_2
 - Apparition d'un canal N
- Champ électrique entre Drain et Source
 - Champ V_{DS} implique courant I_{DS}
 - Déplacement d'électrons dans le Canal N
 - Courant I_{DS}

Symbole électrique d'un transistor MOS à canal n

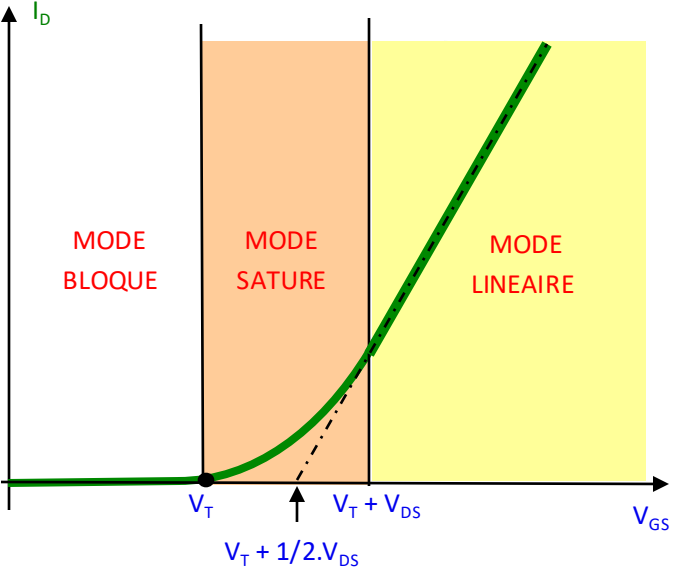


Substrat non représenté si au même potentiel que la source

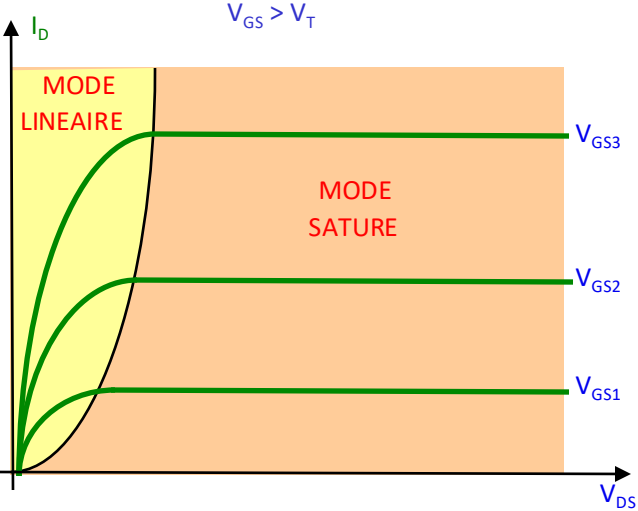
Trois modes différents de fonctionnements

Vision très épurée

Observation des caractéristiques



Caractéristique de transfert



Caractéristique de sortie

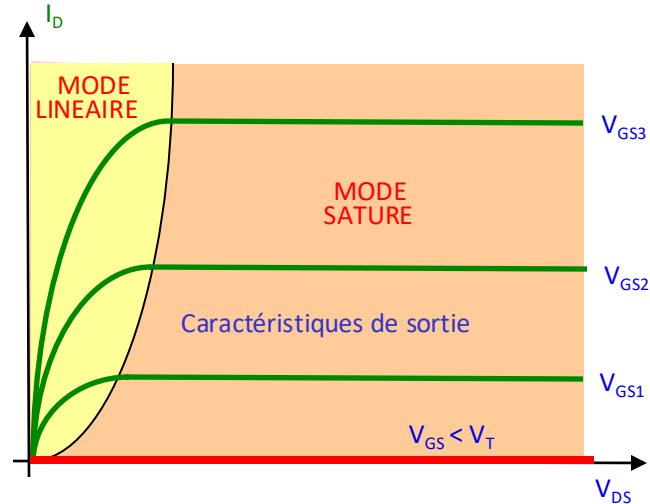
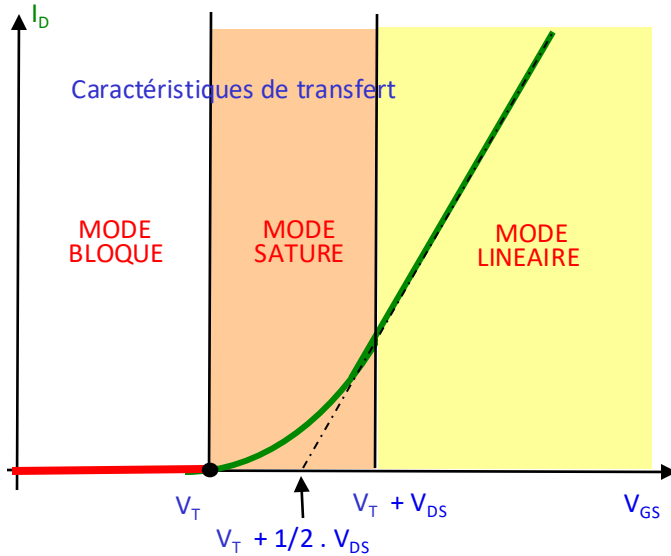
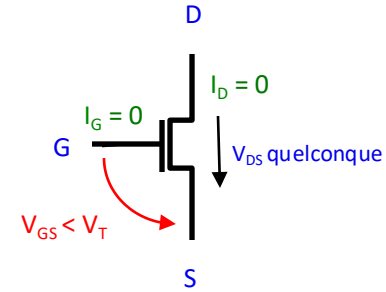
Le mode bloqué

$V_{GS} = V_{GB}$ est inférieure à V_T (-2V 2V)

- Pas d'apparition du canal.

MOS ne conduit aucun courant

- (idem bipolaire) $I_D = 0$



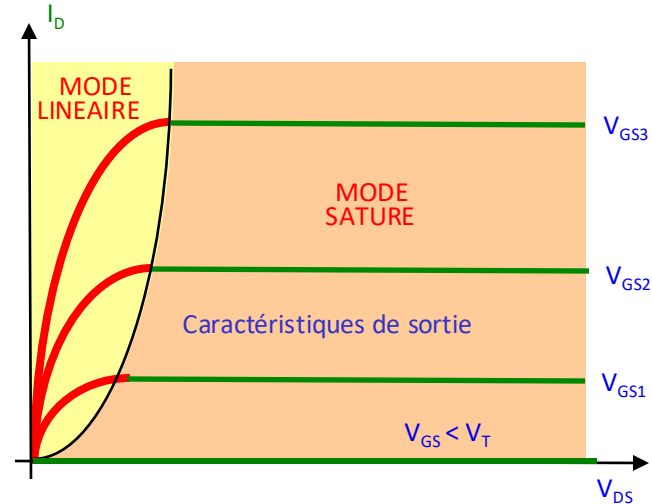
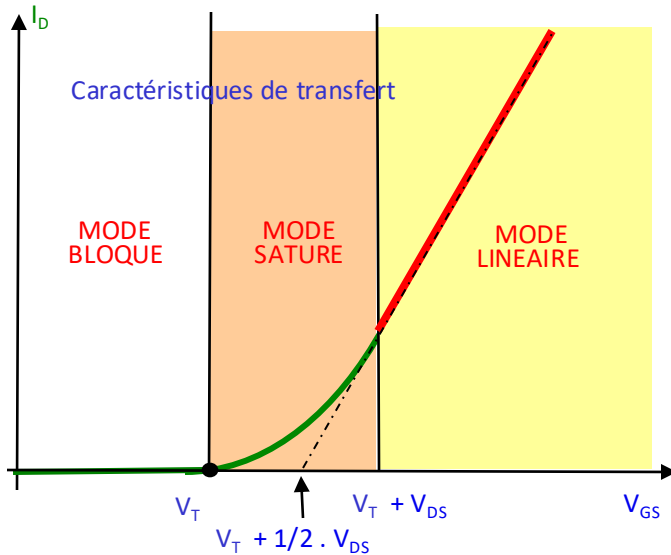
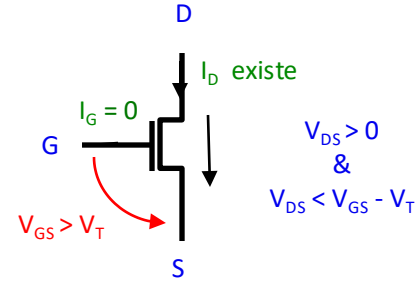
Le mode linéaire (ou mode de conduction)

$$V_{GS} > V_T \text{ \& } V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

- Canal non uniforme entre source et drain.

Le transistor conduit

- $I_D = ?$ (augmente avec la tension V_{DS})



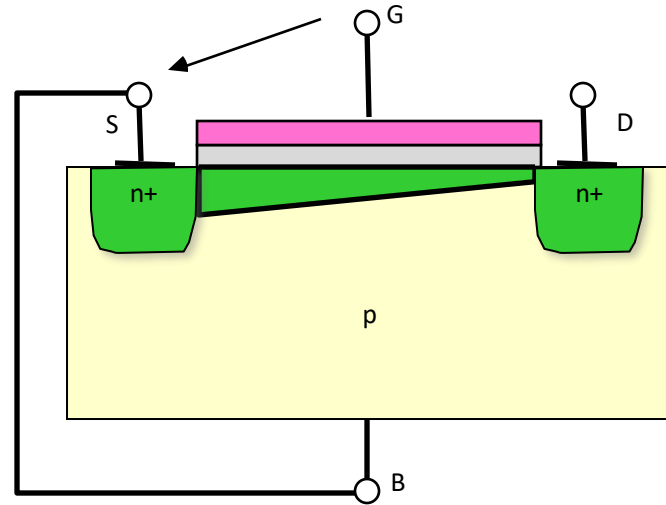
MOST en régime linéaire (linear mode)

$$V_{GS} > V_T \quad \& \quad 0V < V_{DS} < V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

$$I_D = K \cdot V_{DS} \cdot \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$

$$K = \mu \cdot C_{OX} \cdot \frac{W}{L}$$

K = transconductance du MOST
en A/V² ou μ A/V²,
f(technologie, dimensions du MOS)



μ = **mobilité** des porteurs (- pour N-MOST et + pour P-MOST)

Pas de **PINCH-OFF** (pincement) du canal dans ce mode

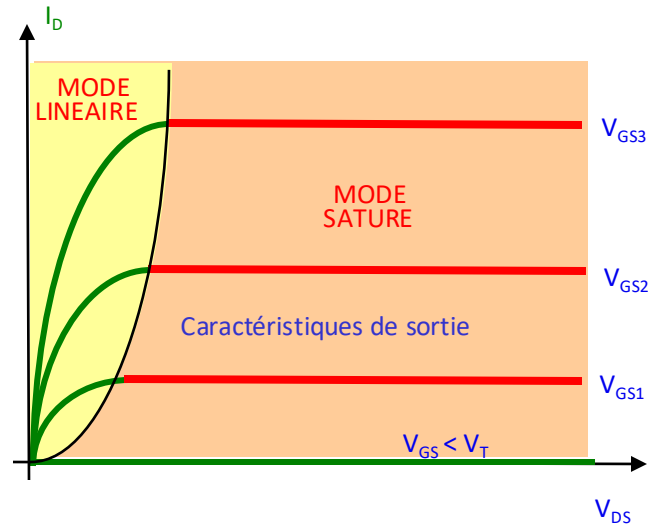
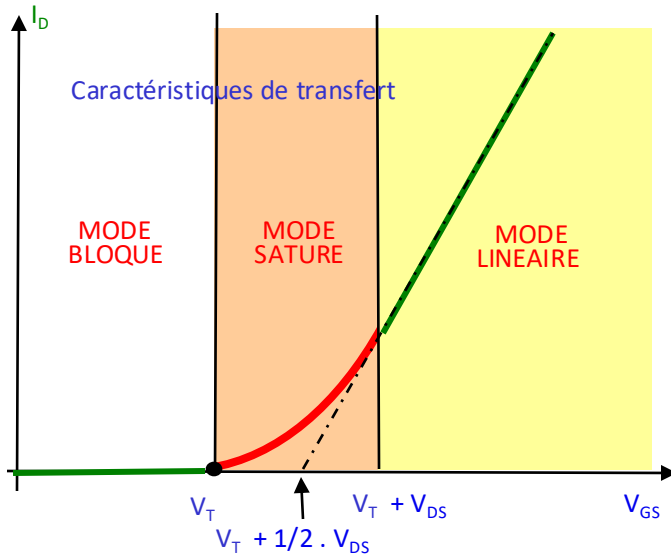
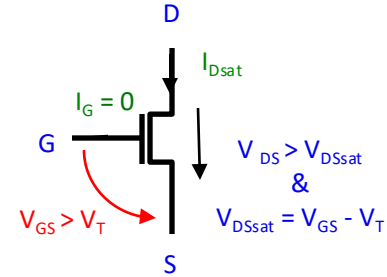
Le mode saturé

$$V_{GS} > V_T \text{ \& } V_{DS} > V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

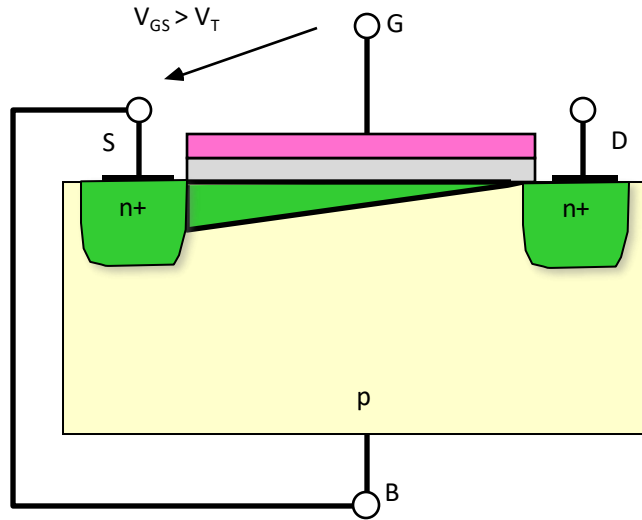
- Canal existe avec pincement côté drain
- V_{DSsat} varie avec V_{GS} et vaut: $V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$

Le transistor conduit

- $I_D = ?$ (augmente avec la tension V_{DS})



MOST en régime saturé (saturation mode)



$$V_{DS} > V_{DSsat}$$

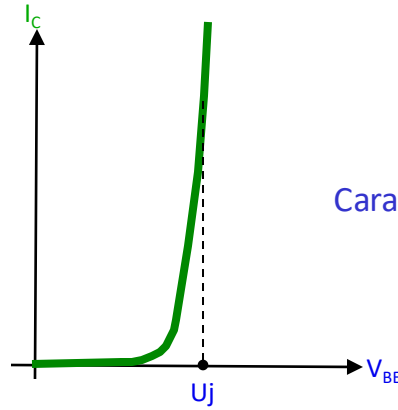
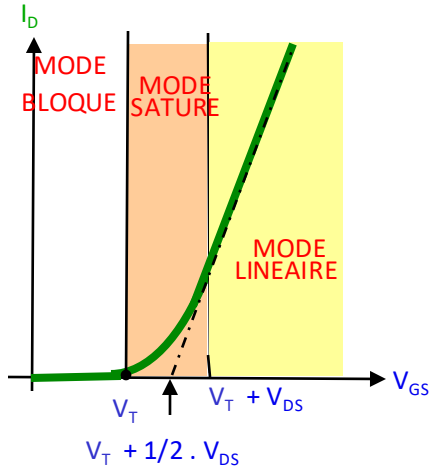
ou

$$V_D > V_{Dsat}$$

PINCH-OFF (Pincement) du canal côté Drain
Le courant ne varie plus avec V_{DS}

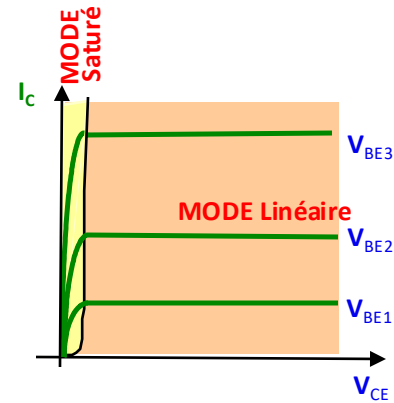
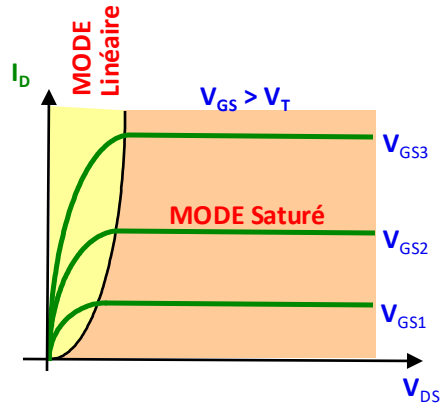
$$I_D = \frac{K}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

Comparaison MOS & bipolaire



Caractéristique de transfert

Caractéristique de sortie



Résumé

Caractéristiques de sortie:

Mode linéaire vers mode saturé avec V_{DS} croissantes

Caractéristique de transfert:

Mode saturé vers mode linéaire avec V_{GS} croissantes

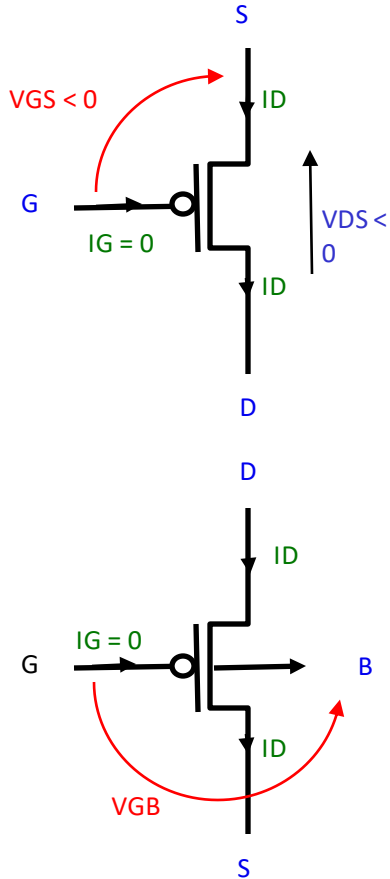
Mode saturé :

$$\left. \begin{array}{l} V_{DS} > V_{DSsat} \\ V_{DS} > V_{GS} - V_T \text{ ou } V_{GS} < V_{DS} + V_T \end{array} \right\} I_D = \frac{K}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

Mode linéaire :

$$\left. \begin{array}{l} V_{DS} < V_{DSsat} \\ V_{DS} < V_{GS} - V_T \text{ ou } V_{GS} > V_{DS} + V_T \end{array} \right\} I_D = K \cdot V_{DS} \cdot \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$

Caractéristiques électriques du p-MOS



Le mode **BLOQUE** : $V_{GS} > V_T$ & $I_D = 0$

Le mode **LINEAIRE** : $V_{GS} < V_T$ & $V_{DS} > V_{DSsat}$

$$I_D = K \cdot V_{DS} (V_{GS} - V_T - 1/2 V_{DS})$$

Le mode **SATURE** : $V_{GS} < V_T$ et $V_{DS} < V_{DSsat}$

$$I_D = K/2 (V_{GS} - V_T)^2$$

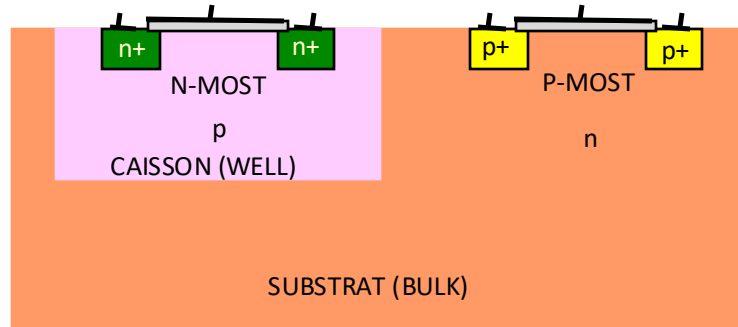
Tension de seuil V_T négative.

La tension de saturation V_{DSsat} est aussi négative:

$$V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

La technologie CMOS

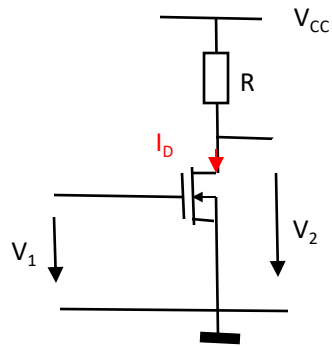
Complementary Metal Oxide Semiconductor



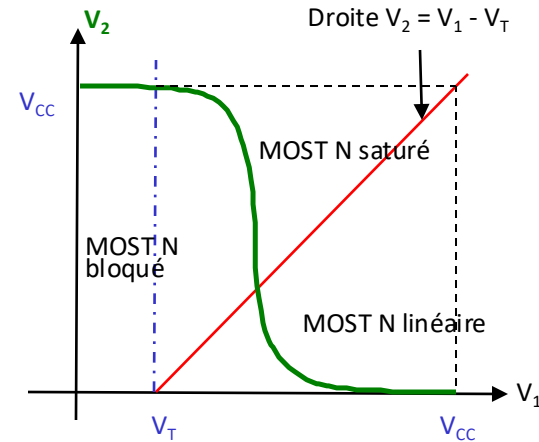
EXERCICE 1

Inverseur logique N-MOS

Calculer et tracer la caractéristique de transfert $V_2 = f(V_1)$.



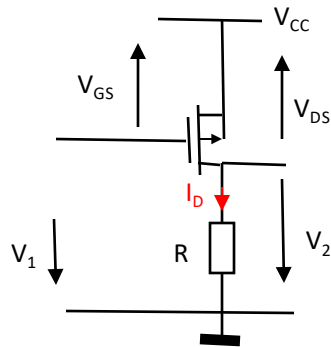
$V_{CC} = 5\text{ V}$
 $V_T = 0.5\text{ V}$
 $K = 50\ \mu\text{A}/\text{V}^2$
 $R = 10\ \text{k}\Omega$



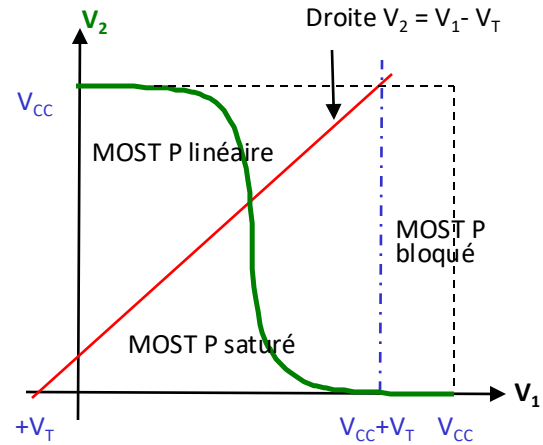
EXERCICE 2

Inverseur logique P-MOS

Calculer et tracer la caractéristique de transfert $V_2 = f(V_1)$.



$$\begin{aligned}V_{CC} &= 5 \text{ V} \\V_T &= -0.5 \text{ V} \\K &= 50 \mu\text{A}/\text{V}^2 \\R &= 10 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$



EXERCICE 3

Inverseur logique **CMOS**

Calculer et tracer la caractéristique de transfert $V_2 = f(V_1)$.

